

УДК 544.225.2:544.223.22:548.713.022.723

## ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА И ДИНАМИКА РЕШЕТКИ КРИСТАЛЛА $\alpha$ -ZnCl<sub>2</sub>

Ю.М. Басалаев, С.А. Маринова

Кемеровский государственный университет, Россия  
E-mail: ymbas@mail.ru

Статья поступила 12 января 2015 г.

Из первых принципов с использованием метода функционала плотности вычислены электронный энергетический спектр кристалла и его подрешеток, плотность состояний, полная и деформационная плотности распределения заряда валентных электронов для кристаллической  $\alpha$ -фазы хлористого цинка. Вычислены оптические колебательные моды.

DOI: 10.15372/JSC20150502

**Ключевые слова:** хлорид цинка, ZnCl<sub>2</sub>, халькопирит, метод подрешеток.

### ВВЕДЕНИЕ

Хлорид цинка в зависимости от условий кристаллизуется в четырех основных модификациях [ 1—10 ], которые отличаются по симметрии:  $\alpha$ -ZnCl<sub>2</sub> (тетрагональная —  $I\bar{4}2d$ ,  $D_{2d}^{12}$ , № 122),  $\beta$ -ZnCl<sub>2</sub> (моноклинная —  $P12_1/c1$ ,  $C_{2h}^5$ , № 14),  $\gamma$ -ZnCl<sub>2</sub> (тетрагональная —  $P42/nmc$ ,  $D_{4h}^{15}$ , № 137) и  $\delta$ -ZnCl<sub>2</sub> (орторомбическая —  $Pna21$ ,  $C_{2v}^9$ , № 33). В настоящее время к одной из слабо изученных как экспериментально, так и теоретически модификаций относится тетрагональная фаза  $\alpha$ -ZnCl<sub>2</sub>.

Целью данной работы является теоретическое исследование электронного и колебательного строения кристалла  $\alpha$ -ZnCl<sub>2</sub> со структурой дефектного халькопирита [ 1—3 ], особенность которой состоит в том, что одна из катионных подрешеток полностью вакантна.

Расчет электронной структуры кристалла  $\alpha$ -ZnCl<sub>2</sub> и его подрешеток выполнен в рамках линейного приближения теории функционала плотности (DFT—LDA) с использованием псевдо-потенциалов типа Perdew—Zunger, генерированных *ab initio* программным кодом PWscf [ 11 ]. Энергия обрыва базиса плоских волн составляла 40 Ry. Зонную структуру  $\alpha$ -ZnCl<sub>2</sub> вычисляли вдоль направлений между наиболее важными точками высокой симметрии зоны Бриллюэна халькопирита:  $T = (001) \rightarrow \Gamma = (000) \rightarrow N = (1/2 \ 1/2 \ 0)$ , где координаты указаны в единицах  $(2\pi/a, 2\pi/a, 2\pi/c)$ . Для интегрирования по зоне Бриллюэна применяли метод специальных точек Монкхорста—Пака [ 12 ] с сеткой  $4 \times 4 \times 4$ , что является достаточным условием получения хорошей сходимости электронного спектра по полной энергии не хуже  $10^{-3}$  эВ/атом и спектра колебательных частот в пределах нескольких десятых долей см<sup>-1</sup>. При нахождении плотности состояний  $N(E)$  использовали сетку  $16 \times 16 \times 16$ .

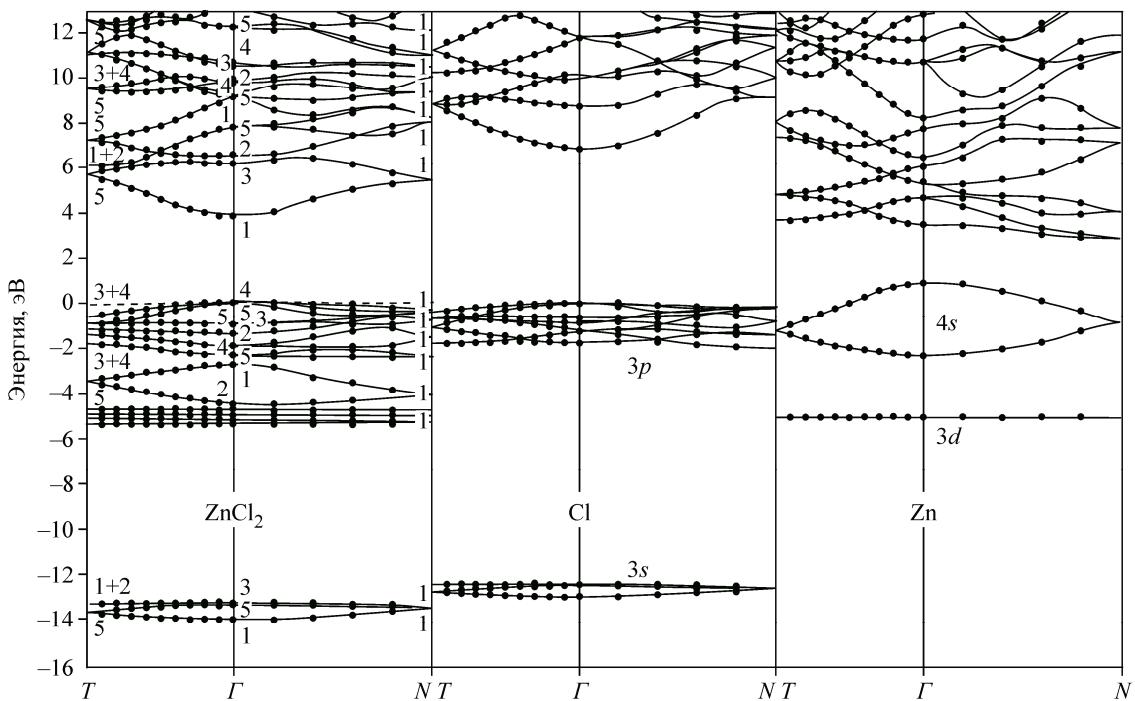
Параметры кристаллической решетки  $\alpha$ -ZnCl<sub>2</sub>, необходимые для расчета, были определены экспериментально более полувека назад:  $a = 5,4$  и  $c = 10,35$  Å [ 1 ];  $a = 5,398$  и  $c = 10,33$  Å [ 2 ];  $a = 5,41$  и  $c = 10,30$  Å [ 3 ]. Во всех работах  $u = 0,25$ , т.е. смещение атомов хлора отсутствует. Оптимизация геометрии кристалла, выполненная с использованием параметров  $a$  и  $c$  из работ

[ 1—3 ], показала, что равновесный параметр  $u = 0,254$ . Это значение отличается от идеального всего на 1,6 %. Длина связи  $R_{\text{ZnCl}} = 2,31 \text{ \AA}$ .

### ЭЛЕКТРОННОЕ СТРОЕНИЕ

Структура валентной зоны  $\alpha\text{-ZnCl}_2$ , вычисленная с использованием кода PWscf [ 11 ], представлена на рис. 1 и по топологии подобна структуре валентных зон Zn-содержащих соединений с решеткой халькопирита [ 13—15 ]. За начало отсчета шкалы энергий выбрано положение вершины валентной зоны (последний заполненный уровень с симметрией  $\Gamma_{4v}$ ). Согласно расчету абсолютный максимум валентной зоны и абсолютный минимум зоны проводимости  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  находятся в точке  $\Gamma$  с симметрией  $\Gamma_{4v}$  и  $\Gamma_{1c}$  соответственно, следовательно,  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  является прямозонным кристаллом. Поскольку кристаллы  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  имеют сравнительно слабое тетрагональное сжатие ( $\gamma = 1,916$ ) и малое смещение анионов ( $u = 0,254$ ), то в вычисленном зонном спектре наблюдается небольшое кристаллическое расщепление  $\Delta_C = 0,07 \text{ эВ}$ . Положение дна зоны проводимости ( $\Gamma_{1c}$ ) и вершины валентной зоны ( $\Gamma_{4v}$ ) определяют ширину прямой запрещенной зоны кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2 E_g = 3,74 \text{ эВ}$ .

Для детального анализа энергетической структуры и химической связи к исследуемому кристаллу  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  был применен метод подрешеток, принципы реализации которого в кристаллах с решеткой халькопирита изложены в работах [ 13—15 ]. Согласно методу подрешеток, кристалл  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  может быть представлен как совокупность отдельных подрешеток, содержащих атомы разного сорта: Zn или Cl. Результаты расчетов зонной структуры для катионной ( $\text{Zn}^{2+}$ ) и анионной ( $\text{Cl}^-$ ) подрешеток представлены на рис. 1. Как в большинстве кристаллов с решеткой халькопирита [ 13—15 ], валентная зона кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  изначально определяется  $s$ - и  $p$ -состояниями анионов:  $3s$ - и  $3p$ -состояниями атомов Cl, которые при взаимодействии с  $4s$ - и  $3d$ -состояниями атомов Zn почти не изменяются. Что касается подрешеточных  $4s$ - и  $3d$ -состояний атомов Zn, то они претерпевают существенные изменения и хорошо прослеживаются в зонной структуре кристалла. Расположенная вблизи  $-4 \text{ эВ}$   $4s$ -зона атомов Zn становится



*Рис. 1.* Зонная структура кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  и его подрешеток (Cl и Zn).  
Цифрами обозначены неприводимые представления в соответствующей точке симметрии кристалла ( $T, \Gamma, N$ )

Рис. 2. Плотность состояний  $N(E)$  и фотоэлектронный спектр кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  [4]

в кристалле вдвое уже, чем в подрешеточном спектре, тогда как зона из  $3d$ -состояний Zn в области энергий  $-5$  эВ наоборот расщепляется, что обусловлено образованием ковалентных связей ( $spd$ -гибридизация) в тетраэдрах  $\text{ZnCl}_4$  между соответствующими состояниями катионных и анионных подрешеток. При этом  $4s$ - и  $3d$ -состояния атомов Zn, расположаясь по энергии между  $3s$ - и  $3p$ -состояниями атомов Cl, "раздвигают" их на величину более 1 эВ (рис. 2).

Расчет полной и локальной парциальной плотности электронных состояний  $N(E)$  кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  показал, что верхняя валентная зона (в интервале энергий от 0 до  $-3$  эВ) образована в основном из  $3p$ -состояний атомов хлора. Расположенные ниже  $-3$  эВ  $4s$ -зона и  $3d$ -зона атомов Zn не перекрываются с  $3p$ -зоной атомов хлора, но содержат существенные вклады этих состояний. Самая нижняя разрешенная валентная зона (в области  $-14$  эВ) фактически полностью сформирована из  $3s$ -состояний атомов хлора. Эти выводы согласуются с фотоэлектронным спектром, измеренным в [4] для ультрафиолетовой области.

Карты полной  $\rho(\mathbf{r})$  и деформационной  $\Delta\rho(\mathbf{r})$  плотностей кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$ , вычисленные с помощью кода CRYSTAL09 [16], построенные в плоскости  $(1\bar{1}0)$ , которая соответствует плоскости халькопирита  $ABX_2$ , содержащей атомы разного сорта, представлены на рис. 3. Положение атомов Zn определяется их координатами  $(0, 0, 0)$  в единицах  $(2\pi/a, 2\pi/a, 2\pi/c)$ , которые транслируются по катионной подрешетке A. Соответственно, атомы Cl с базовыми координатами  $(u, 0,25, 0,125)$  упорядоченно занимают позиции в анионной подрешетке халькопирита X. Квадрат с буквой «V» на рис. 3 обозначает вакансию — пустую катионную подрешетку B в решетке халькопирита с базовыми координатами  $(0,5, 0,5, 0)$ .

Деформационная плотность  $\Delta\rho(\mathbf{r})$  визуализирует перераспределение электронной плотности при образовании кристалла из свободных атомов и может принимать положительные и отрицательные значения, что позволяет определить области избыточной электронной плотности, отвечающей, как правило, за образование химической связи.

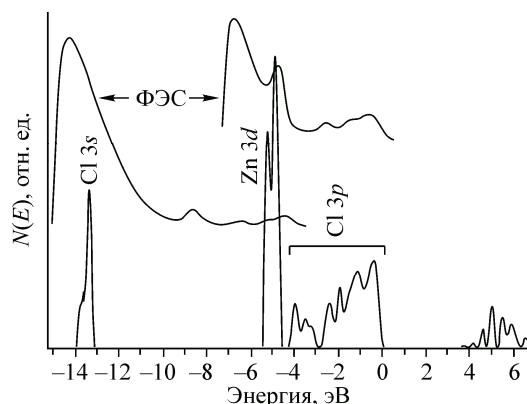
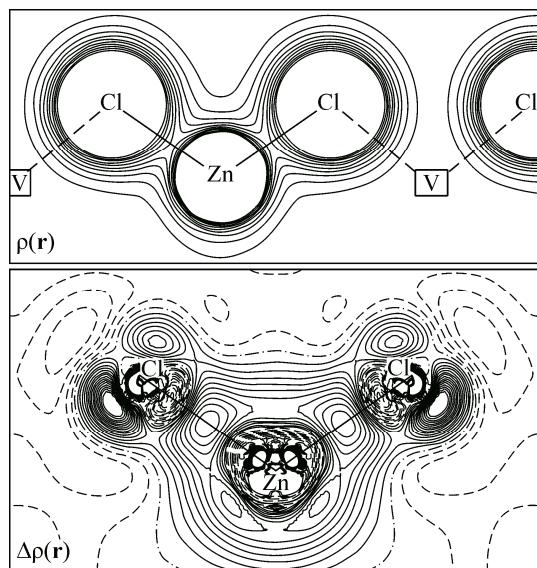


Рис. 3. Полная  $\rho(\mathbf{r})$  и деформационная  $\Delta\rho(\mathbf{r})$  электронная плотность кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$ .

Штриховая линия обозначает  $\Delta\rho(\mathbf{r}) < 0$ , штрих-пунктирная —  $\Delta\rho(\mathbf{r}) = 0$ , сплошная —  $\Delta\rho(\mathbf{r}) > 0$



Карта деформационной плотности  $\Delta\rho(\mathbf{r})$  кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  показывает наличие локализованного на связи заряда (см. рис. 3), обусловленного ковалентной составляющей связи Zn—Cl. Вычисленная по Полингу [17] степень ионности связи Zn—Cl равна 0,249.

### КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ МОДЫ

Изучение колебательных мод в кристаллах имеет фундаментальное значение и представляет практический интерес. Поскольку колебательные моды очень чувствительны к химическому составу и структурному совершенству материала, их знание позволяет обеспечить контроль качества исследуемых образцов.

Примитивная ячейка кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  с решеткой дефектного халькопирита содержит 6 атомов, следовательно, в кристалле распространяется по 6 типов колебаний с продольной (LO) и поперечной (TO) поляризацией (одна акустическая и пять оптических). Спектр решеточных колебаний дефектного халькопирита состоит из 18 ветвей (3 — акустические моды и 15 — оптических мод колебаний). Точечная группа симметрии дефектного халькопирита  $D_{2d}^{12}$  включает 5 неприводимых представлений, из которых 4 однократные ( $A_1 = \Gamma_1$ ,  $A_2 = \Gamma_2$ ,  $B_1 = \Gamma_3$ ,  $B_2 = \Gamma_4$ ) и одно двукратное ( $E = \Gamma_5$ ). Поэтому длинноволновые нормальные колебания  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  преобразуются по неприводимым представлениям группы  $D_{2d}^{12}$  в точке  $\Gamma$  следующим образом:  $\Gamma_{\text{tot}} = A_1 + 2A_2 + 2B_1 + 3B_2 + 5E$ . Без учета акустических мод (неприводимые представления  $\Gamma_4$  и  $\Gamma_5$ ) разложение оптических колебаний по неприводимым представлениям имеет вид:  $\Gamma_{\text{opt}} = A_1 + 2A_2 + 2B_1 + 2B_2 + 4E$ . Все моды активны в спектрах комбинационного рассеяния (КР). Исключение составляют: мода  $\Gamma_2$ , которая не проявляет активности ни в рамановском рассеянии, ни в инфракрасном (ИК) поглощении, а также моды  $\Gamma_4$  и  $\Gamma_5$ , которые активны в ИК и КР процессах.

Результаты наших первопринципных расчетов фононных частот кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  в центре зоны Бриллюэна приведены в табл. 1 и в целом хорошо согласуются с результатами теоретических расчетов с использованием методов молекулярной динамики [6] и экспериментальными данными, полученными в работах [7—9]. Как отмечают авторы экспериментальных работ, исследования кристаллов  $\text{ZnCl}_2$  сильно осложнены из-за их высокой гигроскопичности.

В двухкационных кристаллах  $ABX_2$  со структурой халькопирита колебательный спектр обычно разделяют на три области (высокочастотная, среднечастотная и низкочастотная) [15, 18]. При большом различии масс катионов  $A$  и  $B$  в высокочастотную часть спектра основной вклад дают колебания более легких катионов, а в низкочастотную — более тяжелых катионов, в среднечастотной области участвуют колебания обоих катионов. Такой подход позволяет оценить соотношение силовых констант на связях  $A—X$  и  $B—X$  и взаимодействие между катионами и анионами в кристалле на уровне первых и вторых соседей. В дефектном халькопирите  $AX_2$  нет катиона сорта  $B$ , а все связи  $A—X$  эквивалентны.

Поскольку в кристалле  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  имеется один катион и единственная связь Zn—Cl, обусловленная тетраэдрическим окружением каждого атома Zn четырьмя атомами Cl, то разделе-

Таблица 1

Частоты оптических фононов  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  в точке  $\Gamma$  зоны Бриллюэна, см<sup>-1</sup>

Ссылка	Мода				
	$A_1$ (КР)	$A_2$	$B_1$ (КР)	$B_2$ (ИК, КР)	$E$ (ИК, КР)
Наш расчет	240	118, 321	131, 299	107, 311	83, 106, 294, 328
Теор. [6]	223	147, 301	94, 273	111, 325	75, 99, 263, 327
Эксп. [7]	233	—	113	128	82, 103
Эксп. [8]	245	—	117	128	80, 103
Эксп. [9]	226	—	—	—	76, 100

Таблица 2

Величины эффективных зарядов Борна  $Z^*$  в единицах заряда электрона

Атом	Zn	Cl
$Z^*$	$\begin{pmatrix} 1,90 & -0,23 & 0,00 \\ 0,23 & 1,90 & 0,00 \\ 0,00 & 0,00 & 2,17 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -0,78 & 0,00 & 0,00 \\ -0,00 & -1,10 & -0,51 \\ 0,00 & -0,51 & -1,10 \end{pmatrix}$

ние колебательного спектра на какие-либо области по массе атомов затруднено. Можно выделить частоты с преобладающим вкладом катиона или аниона. Как следует из теоретико-группового анализа, чисто анионными являются моды, отвечающие неприводимым представлениям  $\Gamma_1$  и  $\Gamma_2$ , которые относятся к области средних частот (см. табл. 1). Преобладающий вклад колебаний атома Zn соответствует единственной моде  $106\text{ cm}^{-1}$  ( $\Gamma_5$ ) в низкочастотной области спектра, что объясняется почти вдвое большей массой Zn по отношению к массе Cl. Преимущественно анионной является высокочастотная область, в которой сосредоточены колебания с модами выше  $300\text{ cm}^{-1}$ . Остальные моды содержат примерно одинаковые вклады от обоих атомов и характеризуют колебания связки Zn—Cl. Колебаниям катионной и анионной подрешеток в противофазе отвечают частоты  $131$  и  $299\text{ cm}^{-1}$  с симметрией  $\Gamma_3$ . Эти результаты в принципе не противоречат данным работы [6], где авторы, анализируя экспериментальную и расчетную фононную плотность состояний кристалла  $\text{ZnCl}_2$ , делают вывод о наличии трех областей соответствующих преобладающим колебаниям атомов Zn или Cl и совместным колебаниям пары атомов Zn—Cl.

Вычисленные динамические заряды равны  $1,991$  (Zn) и  $-0,997$  (Cl), а эффективные заряды Борна  $Z^*$  представлены в табл. 2.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное теоретическое исследование электронной и колебательной структуры кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$ , с решеткой дефектного халькопирита, отличающейся от решетки халькопирита наличием упорядоченной вакансии в одной из катионных подрешеток, позволило установить ряд особенностей. В частности, отсутствие катионов другого сорта в однокатионных кристаллах  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  ( $AX_2$ ), в отличие от их тройных двухкатионных аналогов  $ABX_2$  со структурой халькопирита: 1) не исключает наличия тетрагонального сжатия (оно составило  $4,2\%$ ); 2) фактически не влияет на положение анионов в ГЦК подрешетке (отклонение от идеального значения составляет всего  $\pm 0,004$ ); 3) в зонном спектре характеризуется небольшим ( $0,07\text{ эВ}$ ) расщеплением вблизи вершины валентной зоны.

Вычисление зонной структуры кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  с использованием метода подрешеток дает наглядное представление о происхождении и формировании валентной зоны кристалла из подрешеточных состояний. Положение нижней и верхней части валентной зоны определяются  $3s$ - и  $3p$ -состояниями атомов Cl. При образовании химической связи в кристалле  $4s$ - и  $3d$ -состояния атомов Zn не только изменяют свою конфигурацию, но и приводят к смещению  $3s$ - и  $3p$ -состояний атомов Cl в разные стороны более чем на  $1\text{ эВ}$ .

Карты деформационной плотности распределения заряда валентных электронов определяют  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  как кристалл с ионно-ковалентной связью, образованной по донорно-акцепторному механизму, ковалентная составляющая которой имеет существенный вклад и характеризуется избыточным зарядом, локализованным в центре связи Zn—Cl.

Несмотря на наличие одного катиона и одной связи Zn—Cl в колебательном спектре кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$ , удалось выделить частоты с преобладающим вкладом атомов Zn или Cl. Существенную роль в этом сыграли теоретико-групповой анализ и значительное различие масс катиона (Zn) и аниона (Cl).

Полученные нами из первых принципов для кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  результаты и выводы не противоречат известным теоретическим и экспериментальным данным. Подобные расчеты электронного и колебательного строения дают достаточно полное представление об особенностях идеального кристалла  $\alpha\text{-ZnCl}_2$  и позволяют учесть влияние электронного строения на динамические свойства.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках государственного задания № 3.1235.2014 К.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Brühler B.* // Naturwissenschaften. – 1959. – **46**, N 19. – P. 554.
2. *Oswald H.R., Jaggi H.* // Helv. Chim. Acta. – 1960. – **43**, N 1. – P. 72.
3. *Brühler B.* // Zeitschrift für Kristallographie. – 1961. – **115**, N 1-6. – P. 373.
4. *Pong W., Okada S.K.* // Phys. Rev. B. – 1979. – **19**, N 10. – P. 5307.
5. *Polksy H., Martinez L.M., Leinenweber K. et. al.* // Phys. Rev. B. – 2000. – **61**, N 9. – P. 5934.
6. *Sen A., Rao M.N., Mittal R., Chaplot S.L.* // Pramana – J. Phys. – 2004. – **63**, N 2. – P. 393.
7. *Angell C.A., Wong J.* // J. Chem. Phys. – 1970. – **53**, N 5. – P. 2053.
8. *Sakai M., Kuroda N., Nishina Y.* // J. Phys. Soc. Jpn. – 1985. – **54**, N 11. – P. 4081.
9. *James D.W., Parry R.M., Leong W.H.* // J. Raman Spectr. – 1978. – **7**, N 2. – P. 71.
10. *Бражкин В.В., Катаяма Й. и др.* // Письма в ЖЭТФ. – 2005. – **82**, N 11. – P. 808.
11. *Gianozzi P. et al.* // J. Phys.: Condens. Matter. – 2009. – **21**, N 39. – P. 395502.
12. *Monkhorst H.J., Pack J.D.* // Phys. Rev. B. – 1976. – **13**, N 12. – P. 5188.
13. *Басалаев Ю.М., Поплавной А.С.* // Журн. структур. химии. – 2009. – **50**, № 6. – С. 1232.
14. *Басалаев Ю.М., Поплавной А.С.* Электронное строение тройных алмазоподобных соединений со структурой халькопирита. – Кемерово: ИНТ, 2009.
15. *Basalaev Yu.M., Poplavnoi A.S.* In: Chalcopyrite: Chemical Composition, Occurrence and Uses / Ed. D. Cronin. – New York: Nova Science Publishers, Inc., 2014.
16. *Dovesi R. et al.* // Zeit. Kristallogr. – 2005. – **220**, N 5-6. – P. 571.
17. *Бацанов С.С.* Структурная химия. Факты и зависимости. – М.: Диалог-МГУ, 2000.
18. *Kosobutsky A.V., Basalaev Yu.M., Poplavnoi A.S.* // Phys. Stat. Sol. (b). – 2009. – **246**, N 2. – P. 364.